

产品介绍

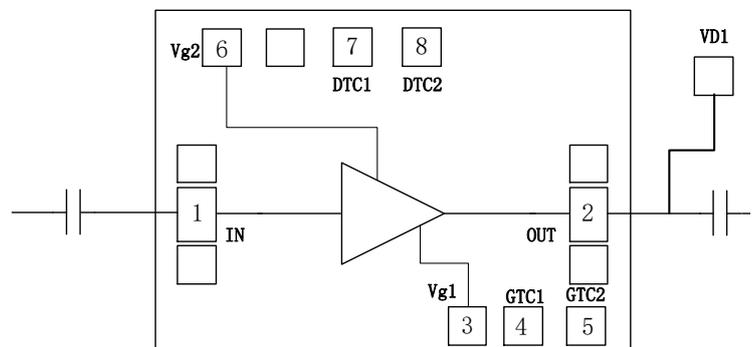
YPA130-0010A1 是一款性能优良的 GaAs 功率放大器芯片，频率范围覆盖 0.1~10GHz，连续波模式下，VD=+12V 时，小信号增益典型值为 13.5dB，饱和输出功率典型值 32dBm，饱和功率附加效率典型值 21%。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：0.1-10GHz
- 小信号增益 (CW)：13.5dB
- 饱和输出功率 (CW)：32dBm
- 饱和功率附加效率 (CW)：21%
- 输入回波损耗 (CW)：15dB
- 输出回波损耗 (CW)：18dB
- 静态工作电流 (CW)：0.4A @+12V
- 芯片尺寸：3.50mm × 1.80mm × 0.10mm

功能框图



电性能表 (TA=+25°C, VD=+12V, VG1=-0.8V, VG2=+5V, CW 模式)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	0.1	—	10	GHz
小信号增益	Gain	12	13.5	—	dB
输入回波损耗	RL_IN	12	15	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	13	18	—	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	30	31	—	dBm
功率附加效率@P1dB	PAE	14	18	—	%
输出3dB压缩功率	OP3dB	30.5	31.5	—	dBm
功率附加效率@P3dB	PAE	15	20	—	%
饱和输出功率	Psat	30.5	32	—	dBm
饱和功率附加效率	PAE	15	21	—	%
静态工作电流*	IDQ	—	0.4	—	A

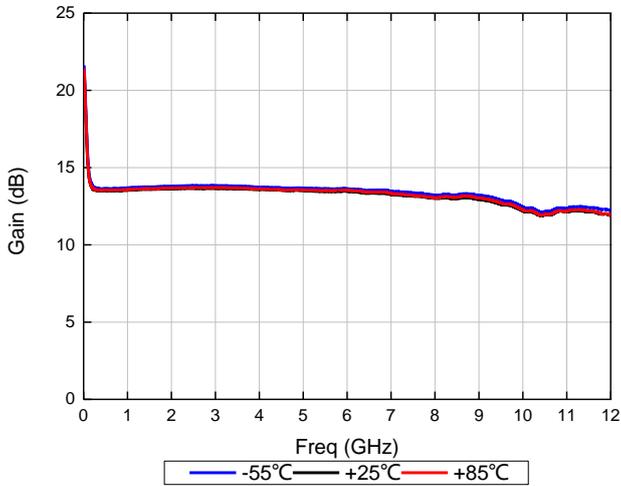
*在-1.1V~-0.6V范围内调节VG1，使静态工作电流为0.4A。参考值：VG1=-0.8V。

使用限制参数

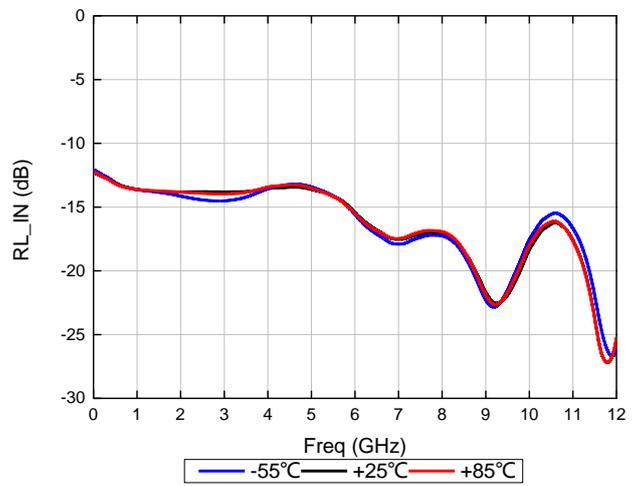
最大漏极工作电压	+14V
最大栅极工作电压	-2.5V
最大输入功率	+30dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

测试曲线 (VD=+12V, VG1=-0.8V, VG2=+5V, IDQ=0.4A, CW模式)

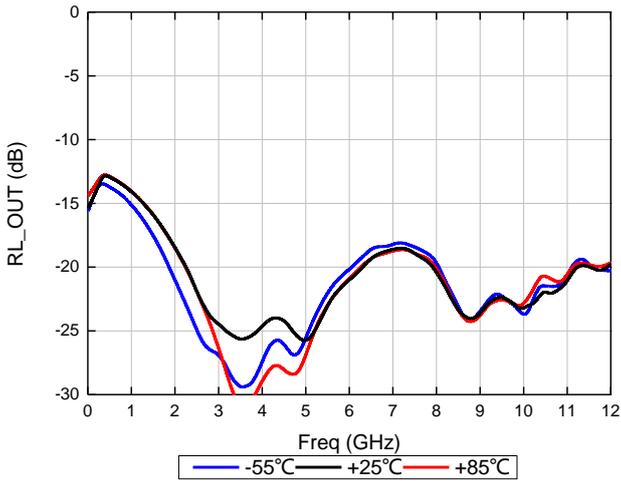
小信号增益



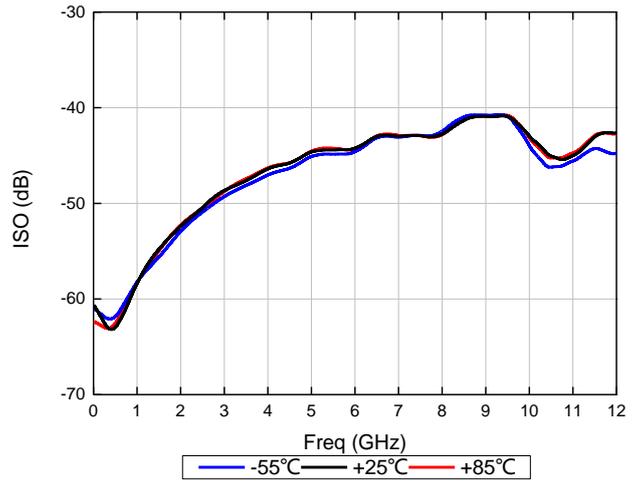
输入回波损耗



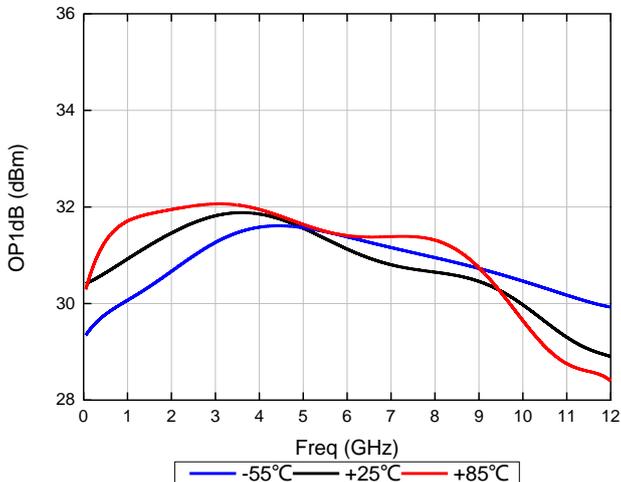
输出回波损耗



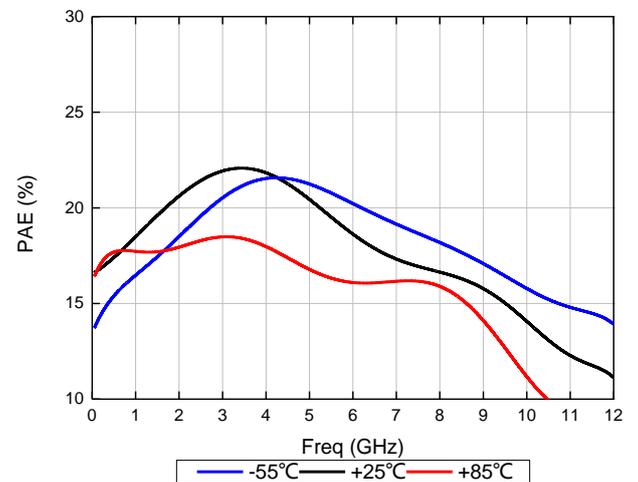
反向隔离度



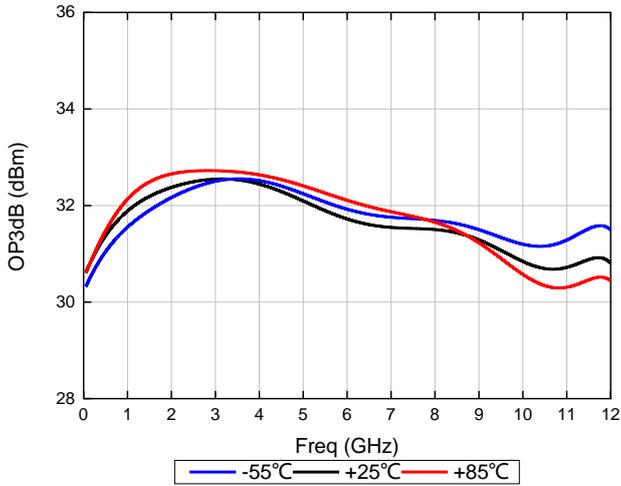
输出 1dB 压缩功率



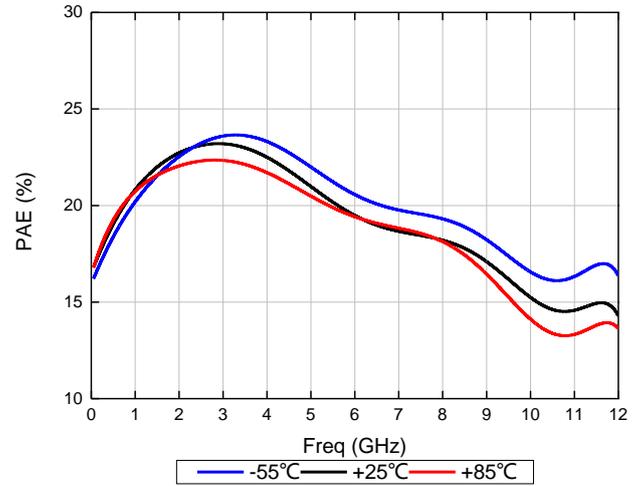
功率附加效率@P1dB



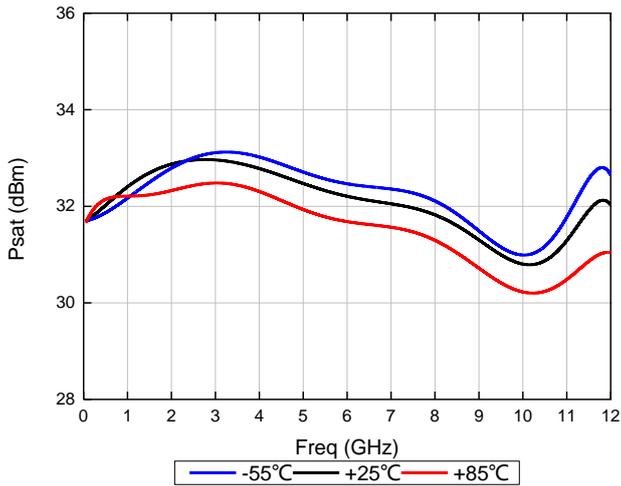
输出 3dB 压缩功率



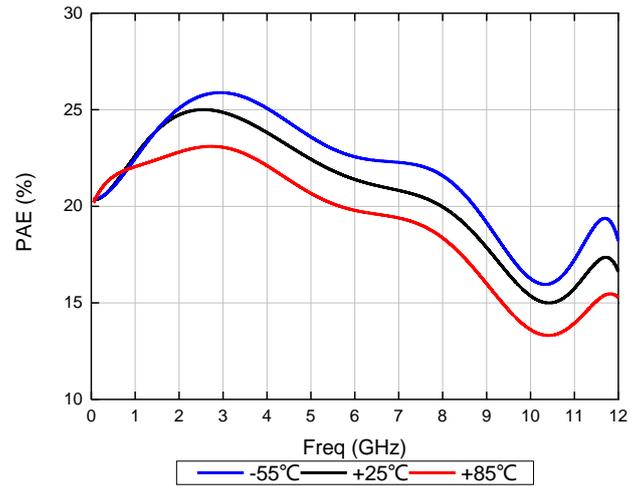
功率附加效率@P3dB

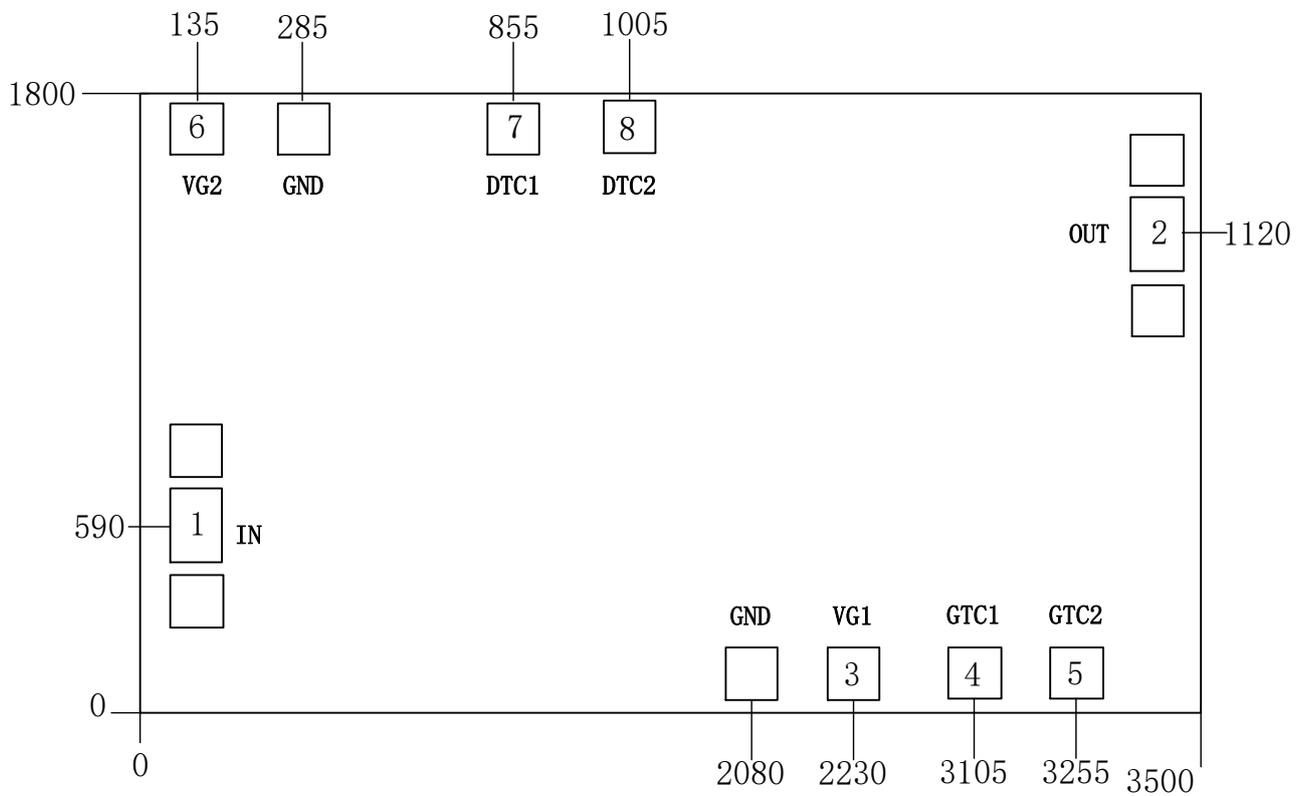


饱和输出功率

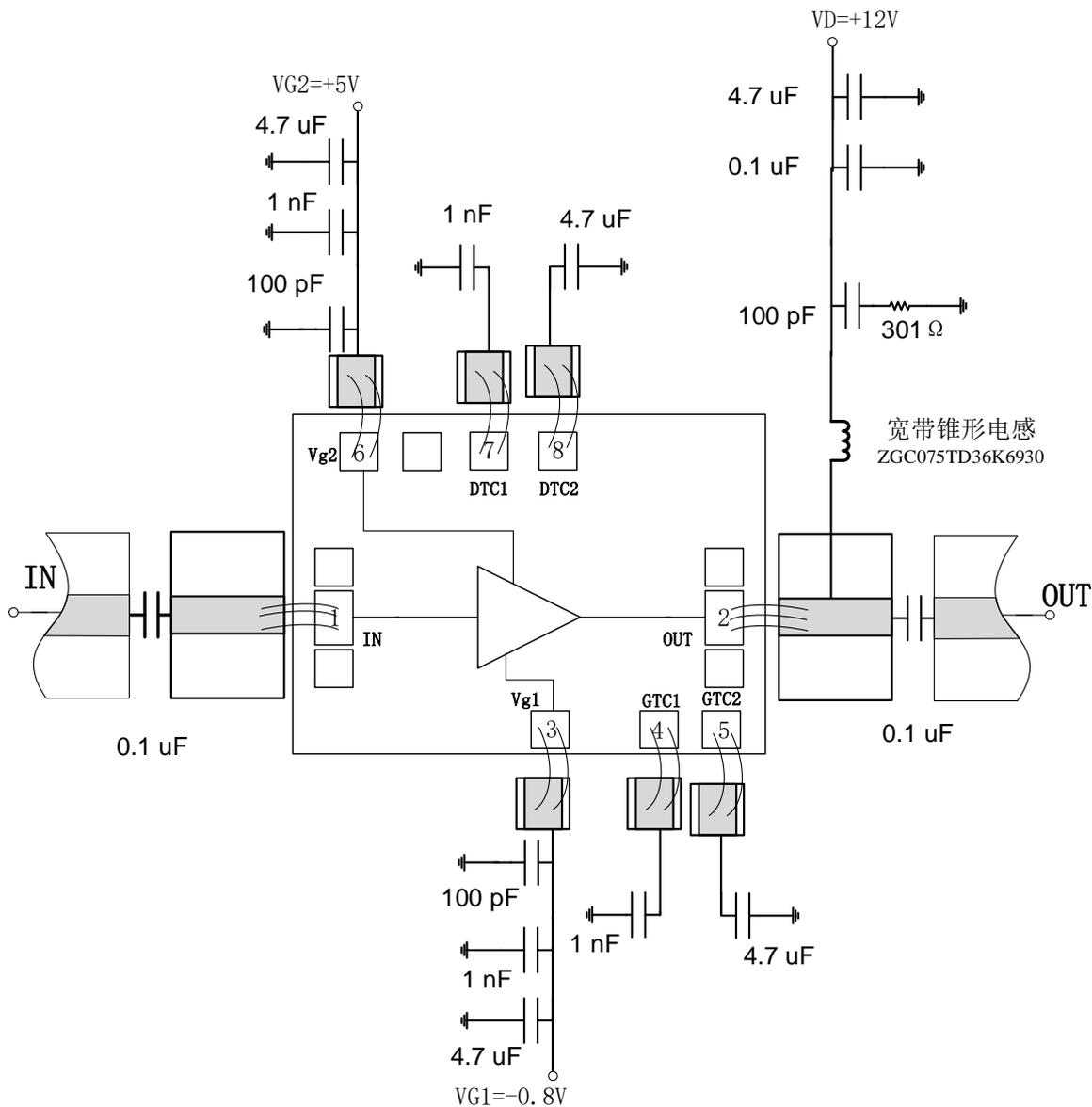


饱和功率附加效率



芯片端口图 (单位: μm)

端口定义

序号	标识	功能定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端, 外接 50 欧姆系统	RF
2	OUT	射频信号输出端, 外接 50 欧姆系统, VD 通过外部偏置 T 型连接器施加	RF VD=+12V
3	VG1	第一级栅极馈电端, 需外置 100pF 电源滤波电容	-0.8V
4	GTC1	栅极低频终止电容	AC GND
5	GTC2	栅极低频终止电容	AC GND
6	VG2	第二级栅极馈电端, 需外置 100pF 电源滤波电容	+5V
7	DTC1	漏极低频终止电容	AC GND
8	DTC2	漏极低频终止电容	AC GND
其他	GND	供探针测试用的接地压点	/

建议装配图

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 3 根键合线（直径 25 μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 600 μm ；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}C$ ，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。